

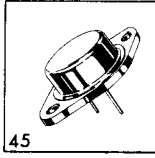
# 2SD732, 732K

## 2SB696, 696K

新製品 暫定規格  
低周波電力増幅用

Epitaxial Mesa Type Silicon Transistor

For AF Power Amplifier Use



- ★[NEW]/Tentative Specification
- ★For output stage of 60 watts power amplifier
- ★Enough ability of voltage, current and antidestruction.

⊖ 467A

- 特長
- ・大電流である。
  - ・高耐圧である。
  - ・破壊に強い。

( )内は 2SB696, 696K の場合を示す。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$		2SB696, 2SD732	2SB696K, 2SD732K	単位
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	(-)150	(-)150	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	(-)120	(-)140	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$		(-)6	V
コレクタ電流	$I_C$		(-)8	A
ピークコレクタ電流	$i_{cp}$		(-)12	A
コレクタ損失	$P_C$	$T_C=25^\circ\text{C}$	80	W
接合部温度	$T_j$		150	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{stg}$		-40~+150	$^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$		min	typ	max	単位
コレクタシャ断電流	$I_{CB0}$ $V_{CB}=(-)80\text{V}, I_B=0$			(-)0.1	mA
エミッタシャ断電流	$I_{EB0}$ $V_{EB}=(-)4\text{V}, I_C=0$			(-)0.1	mA
直流電流増幅率	$h_{FE}(1)^*$ $V_{CE}=(-)5\text{V}, I_C=(-)1\text{A}$	40*		320*	
	$h_{FE}(2)$ $V_{CE}=(-)5\text{V}, I_C=(-)6\text{A}$				
利得帯域幅積	$f_T$ $V_{CE}=(-)5\text{V}, I_C=(-)1\text{A}$		15		MHz
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$ $V_{CE}=(-)5\text{V}, I_C=(-)1\text{A}$			(-)1.5	V
C-E 飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ $I_C=(-)5\text{A}, I_B=(-)0.5\text{A}$			(-)0.6	V
C-B 降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$ $I_C=(-)5\text{mA}, I_E=0$		B696, D732	(-)150	V
			B696K, D732K	(-)150	V
C-E 降伏電圧	$V_{(BR)CEO}(1)$ $I_C=(-)5\text{mA}, R_{BE}=\infty$		B696, D732	(-)120	V
			D696K, D732K	(-)140	V
	$V_{(BR)CEO}(2)$ $I_C=(-)50\text{mA}, R_{BE}=\infty$		B696, D732	(-)120	V
			D696K, D732K	(-)140	V
E-B 降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$ $I_E=(-)5\text{mA}, I_C=0$			(-)6	V

\* 2SB696, K/2SD732, Kは  $1\text{A } h_{FE}$  によりつぎのように分類している。

40	C	80	60	D	120	100	E	200	160	F	320
----	---	----	----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

◇関連製品： 9. 応用回路集 の 8. オーディオアンプ  
ラインアップ表を参照されたい。

